



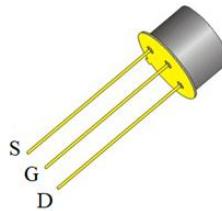
MOS 场效应晶体管系列产品

LYNM230G 大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

LYNM230G 型大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管具有开关速度快、损耗小、输入阻抗高、驱动功耗小安全工作区宽、温度稳定性好等优点。该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大功能。

器件采用 A3-02B 型金属封装，静电放电敏感度为 500V，A3-02B 典型重量 1.13g。



A3-02B 型

2 质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ1005QZ，QJZ840611。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	P_D^{a} $T_C=25^\circ\text{C}$ W	V_{GS} V	I_{DM1} $T_C=25^\circ\text{C}$ A	I_{DM2} $T_C=100^\circ\text{C}$ A	T_{jM} °C	T_{stg} °C
LYNM230G	25	± 20	5.5	3.5	150	-55~150

^a $T_C > 25^\circ\text{C}$ 时，按 0.12W/°C 线性降额。

4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

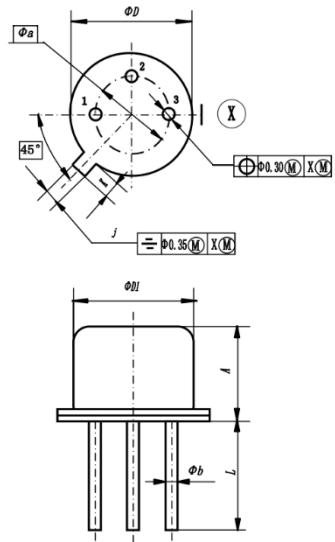
表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(\text{ON})}$	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=I_{DM2}$	—	—	0.40	Ω
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_D=1.0\text{mA}$	200	—	—	V
开启电压	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=0.25\text{mA}$	2.0	—	4.0	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}$, $V_{GS}=0\text{V}$	—	—	25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20\text{V}$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20\text{V}$	—	—	-100	nA
电容	C_{iss}	$V_{DS}=100\text{V}$, $I_D=5.5\text{A}$, $V_{GS}=10\text{V}$	—	42.1	—	pF



MOS 场效应晶体管系列产品

5、外形尺寸



引出端极性: 1-源极 2-栅极 3-漏极

单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典 型 值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φ_a	—	5.08	—
Φ_b	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.612	0.787	0.963
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

A3-02B 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。